

	<h2>SI3443DDV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3443DDV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3443DDV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45277 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3443DDV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	45277 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta), 2.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4A (Ta), 5.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 4.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	970pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3443DDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3443DDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443DDV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3443BVD</b> VISHAY SI3443BVD VISHAY</p>	 <p><b>SI3443DV</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4A SSOT-6</p>	 <p><b>SI3443CDV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3443CDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>
 <p><b>SI3443DL-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI3443CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3443CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3443DV</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 20V 4.4A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3441DV-T1-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-GE3
 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442DV	 SI3442DV
 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3	 SI3443BDV
 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BVD
 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3
 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV-NL	 SI3443DV-T1
 SI3443DV-T1-E3	 SI3443DV-T1-GE3	 SI3443DVTR	 SI3443DVTRPBF	 SI3445ADV-T1
 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445BDV
 SI3445DV	 SI3445DV-T1	 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3.
 SI3445DV-T1-GE3	 SI3445DV-T1-GE3	 SI3446ADV-T1	 SI3446ADV-T1-E3	 SI3446ADV-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited